### УДК 536.24



Прибила А.В.

Прибила А.В., канд. физ.-мат. наук<sup>1,2</sup>

 <sup>1</sup>Інститут термоелектрики НАН і МОН України, вул. Науки, 1, Чернівці, 58029, Україна; *e-mail: anatych@gmail.com*;
 <sup>2</sup>Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського 2, Чернівці, 58000, Україна

# ПРОЕКТУВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО МОДУЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ДЕТЕКТОРА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

У роботі наведено результати проектування термоелектричного багатокаскадного термоелектричного модуля охолодження рентгенівських детекторів. Розроблено конструкцію термоелектричного охолоджувача у складі детектора рентгенівського випромінювання та проаналізовано можливості його практичного використання. Бібл. 12, рис. 2.

**Ключові слова:** комп'ютерне проектування, термоелектричне охолодження, рентгенівський детектор.

### Вступ

Загальна характеристика проблеми. Рентгенівські методи широко використовуються для неруйнівних мікроаналітичних досліджень структури і складу матеріалів з високою просторовою роздільною здатністю [1]. Сучасний стан методів ядерного мікроаналізу з використанням сфокусованих пучків іонів МеВ-них енергій з високою моноенергетичністю ( $\Delta E/E = 10^{-5}$ ) дозволяє досягнути просторової роздільної здатності по поверхні до 100 нанометрів і до 10 нанометрів по товщині зразків. Подальше підвищення роздільної здатності суттєво залежить від покращення аналітичних характеристик напівпровідникових детекторів, а також від застосування широкоапертурних позиційно чутливих детекторів випромінювання нових типів [2].

Для підвищення роздільної здатності рентгенівських детекторів важливо вирішити задачу забезпечення оптимальної температури їх роботи [3 – 9].

Вона вирішується шляхом використання напівпровідникових термоелектричних модулів охолодження (ТМО) [5–9], що дозволяють забезпечити необхідну глибину охолодження в мінімальному робочому об'ємі детектора. Так однокаскадні термоелектричні модулі застосовуються для неглибокого охолодження (до 250 К), для охолодження сенсорів до робочої температури 230 К використовуються двокаскадні ТЕО, до температури 210 К – трикаскадні, до температури нижче 190 К – чотири і п'ятикаскадні ТМО [10].

Тому метою роботи є аналіз можливостей термоелектрики для охолодження рентгенівських детекторів та розробка конструкції багатокаскадного термоелектричного охолоджувача рентгенівських детекторів.

#### Фізична модель

Для розрахунків використано фізичну модель термоелектричного охолоджувача у складі детектора рентгенівського випромінювання представлену на рис. 1. Вона складається із корпусу 2 з берилієвим вікном 1, через яке випромінювання потрапляє на рентгенівський детектор 3. Необхідні температурні і теплові умови на поверхні детектора рентгенівського випромінювання забезпечуються багатокаскадним термоелектричним охолоджувачем електричною потужністю W, що складається із віток термоелектричного матеріалу n- і p-типу провідності 8, електропровідних комутуючих пластин 9, керамічних електроізоляційних пластин 10 та електричних виводів 7. Для зменшення теплових втрат всередині корпусу детектора 4 створюється вакуум. Відвід теплового потоку від термоелектричного охолоджувача здійснюються через основу корпусу детектора 5 та його кріплення 6.



Рис. 1. Фізична модель термоелектричного багатокаскадного охолоджувача у складі детектора рентгенівського випромінювання: 1 – берилієве вікно; 2 – корпус приладу;
3 – детектор рентгенівського випромінювання; 4 – внутрішній простір приладу в якому створюється вакуум; 5 – основа корпусу приладу; 6 – кріплення приладу;
7 – електричні виводи; 8 – вітки термоелектричного матеріалу п- і р- типу провідності, 9 – електричні комутаційні пластини, 10 – керамічні електроізоляційні пластини.

### Математичний і комп'ютерний описи моделі

Система рівнянь для опису холодильного коефіцієнту термоелектричного охолоджувача в залежності від параметрів елементів фізичної моделі визначається із рівнянь теплового балансу:

$$Q_{c} = \chi_{1}(T_{c}^{(1)} - T_{c}), \qquad (1)$$

$$\begin{cases} Q_h = \chi_3 (T_h^{(2)} - T_h^{(1)}) \\ Q_h = \chi_4 (T_h^{(1)} - T_h) \end{cases}, \tag{2}$$

$$Q_h = Q_c + W_{TE} \,. \tag{3}$$

Тут  $T_c^{(1)}$  – температура поверхні детектора,  $T_c$  – температура холодної сторони

термоелектричного модуля,  $\chi_1$  – тепловий контактний опір,  $T_h^{(2)}$  – температура гарячої сторони термоелектричного модуля,  $T_h^{(1)}$  – температура основи корпусу детектора,  $T_h$  – температура поверхні на яку відбувається відведення тепла,  $\chi_2$  – тепловий контактний опір,  $\chi_3$  – тепловий опір теплообмінника з «гарячого боку» термоелектричного перетворювача,  $Q_0$  – холодопродуктивність,  $Q_h$  – теплопродуктивність.

Із врахуванням (1) – (3), вираз для холодильного коефіцієнта термоелектричного термоелектричного охолоджувача запишеться у вигляді:

$$\varepsilon_r = \frac{Q_0}{W + W_1} = \frac{\alpha I (T_c + Q_0 N_1) - 0.5I^2 R - \lambda (T_h - T_c - (Q_h N_2 + Q_0 N_1))}{W + W_1},$$
(4)

де  $\alpha$  – диференціальний коефіцієнт Зеєбека матеріалу, *I* – сила струму, *R* – електричний опір термоелектричного модуля,  $\lambda$  – середній питомий коефіцієнт теплопровідності віток термоелектричного модуля, *W*<sub>1</sub> – потужність, що витрачається на забезпечення теплообміну,

$$N_{1} = \frac{(\chi_{1} + \chi_{2})}{\chi_{1}\chi_{2}}, \ N_{2} = \frac{(\chi_{3} + \chi_{4})}{\chi_{3}\chi_{4}}.$$
 (5)

Для проектування конструкції термоелектричного охолоджувача використано пакет прикладних програм COMSOL Multiphysics [11]. Для цього рівняння фізичної моделі необхідно представити у певному вигляді, як буде показано нижче.

Для опису потоків тепла й електрики скористаємося законами збереження енергії

$$div\vec{E} = 0 \tag{6}$$

та електричного заряду

$$div\bar{j} = 0, \tag{7}$$

де

$$\vec{E} = \vec{q} + U\vec{j},\tag{8}$$

$$\vec{q} = \kappa \nabla T + \alpha T \vec{j}, \tag{9}$$

$$\vec{j} = -\sigma \nabla U - \sigma \alpha \nabla T. \tag{10}$$

Тут  $\vec{E}$  – густина потоку енергії,  $\vec{q}$  – густина теплового потоку,  $\vec{j}$  – густина електричного струму, U – електричний потенціал, T – температура,  $\alpha$ ,  $\sigma$ ,  $\kappa$  – коефіцієнти термоЕРС, електропровідності і теплопровідності.

Враховуючи (8) – (10), можна одержати

$$\vec{E} = -(\kappa + \alpha^2 \sigma T + \alpha U \sigma) \nabla T - (\alpha \sigma T + U \sigma) \nabla U.$$
(11)

Тоді закони збереження (5), (6) набувають вигляду:

$$-\nabla \left[ (\kappa + \alpha^2 \sigma T + \alpha U \sigma) \nabla T \right] - \nabla \left[ (\alpha \sigma T + U \sigma) \nabla U \right] = 0,$$
(12)

$$-\nabla(\sigma\alpha\nabla T) - \nabla(\sigma\nabla U) = 0. \tag{13}$$

Нелінійні диференціальні рівняння другого порядку в частинних похідних (12) і (13) визначають розподіл температури *T* та потенціалу *U* у термоелектричному охолоджувачі

Розв'язок цих рівнянь із використанням технології об'єктно-орієнтовано комп'ютерного моделювання [11] та теорії оптимального керування [12] дозволяє знайти оптимальну конструкцію термоелектричного перетворювача та залежності його характеристик.

#### Результати комп'ютерного проектування

В результаті комп'ютерного моделювання розраховано конструкцію термоелектричного багатокаскадного модуля (рис. 2), що забезпечує можливість його використання для забезпечення температурних умов детектора рентгенівського випромінювання.

Таким чином, термоелектричний охолоджувач містить 4 каскади – по 6, 12, 27 і 65 пар віток термоелектричного матеріалу, його габаритні розміри – 12 х 16 х 12 мм при забезпеченні площі охолоджуваної площадки 4 х 8 мм. Розміри віток термоелектричного матеріалу на основі телуриду вісмуту ( $Bi_2Te_3$ ) *n*- і *p*- типів провідності –  $0.6 \times 0.6 \times 1.8$  мм. Електроізоляційні пластини з оксиду алюмінію ( $Al_2O_3$ ) товщиною 0.5 мм, електрична комутація з міді (Cu) із антидифузійним прошарком нікелю (Ni) товщиною 0.1 мм.



*Рис. 2. Схематичне зображення конструкції термоелектричного* охолоджувача для детектора рентгенівського випромінювання.

Розрахункова холодопродуктивність термоелектричного перетворювача складає  $Q_0 = 57$  мВт (3 мВт – теплове навантаження від детектора плюс 54 мВт – натікання через випромінювання). При забезпеченні температури на детекторі  $T_c^{(1)} = -70$  °C та за температури тепловідводу  $T_h = +20$  °C холодильний коефіцієнт термоелектричного охолоджувача становить  $\varepsilon = 0.02$ . Отже, електрична потужність, що буде споживатися таким перетворювачем становить W = 2.85 Вт.

Отримані результати підтверджують можливості використання термоелектричних охолоджувачів для забезпечення температурних і теплових умов детекторів рентгенівського випромінювання і за своїми характеристиками переважають відомі світові аналоги [10].

### Висновки

- 1. Проведено комп'ютерне проектування термоелектричного охолоджувача для рентгенівських детекторів.
- 2. Розраховано конструкцію та характеристики термоелектричного охолоджувача у складі детектора рентгенівського випромінювання. Таким чином, термоелектричний охолоджувач містить 4 каскади з термоелектричного матеріалу на основі *Bi*<sub>2</sub>*Te*<sub>3</sub> габаритними розмірами 12 x 16 x 12 мм при

забезпеченні площі охолоджуваної площадки 4 х 8 мм.

3. Визначено електричну потужність термоелектричного перетворювача W = 2.85 Вт, що при холодильному коефіцієнті  $\varepsilon = 0.02$  забезпечує температуру основи детектора  $T_c^{(1)} = -70$  °C та  $\Delta T = 90$  K.

### Література:

- Buhay O.M., Drozdenko M.O., Storizhko V.Yu. Microanalytical X-ray facility in IAP NASU / O.M. Buhay, M.O. Drozdenko, V.Yu. Storizhko // Nanotechnology and nanomaterials, 27-30 August 2014: Book of Abstract. – Lviv, 2014. – P. 88-89.
- 2. Woldseth R. X-Ray Energy Spectrometry. Kevex: Scotts Valley, CA, 1973.
- R.E. Stone, V.A. Barkley, and J.A Fleming, "Performance of a GammaRay and X-ray Spectrometer using Germanium and Si (Li) Detectors Cooled by a Closed-Cycle Cryogenic Mechanical Refrigerator," IEEE Trans. Nucl. Sci. NS-33(1), 299 (1986).
- 4. E.C. Broerman, R.M. Keyser, T.R. Twomey, D.L. Upp. A new cooler for HPGe detector systems.– ORTEC, PerkinElmer Instruments, Inc Oak Ridge TN 37831-0895 USA.
- 5. Schlesinger TE, James RB. Semiconductors and Semimetals. Vol. 43. Semiconductors for Room Temperature Nuclear Detector Applications. Academic Press: New York, 1995.
- 6. Semiconductors for Room-temperature Detectors. Applications II, Materials Research Society Symposium Proceedings, Vol. 487. Materials Research Society: Warrendale, PA, 1998.
- 7. Sokolov, A., Loupilov, A., & Gostilo, V. (2004). Semiconductor Peltier-cooled detectors for x-ray fluorescence analysis. X-Ray Spectrometry, 33(6), 462–465. doi:10.1002/xrs.744.
- 8. http://www.rmtltd.ru/applications/photodetectors/xray.php.
- 9. http://www.amptek.com/wp-content/uploads/2014/04/XR-100T-CdTe-X-ray-and-Gamma-Ray-Detector-Specifications.pdf.
- 10.Anatychuk L.I., Vihor L.N., The limits of thermoelectric cooling for photodetectors. J. of Thermoelectricity, 2013, №5, p. 54-58.
- 11.COMSOL Multiphysics User's Guide // COMSOLAB. 2010. 804 p.
- 12. Анатычук Л.И., Семенюк В.А. Оптимальное управление свойствами термоэлектрических материалов и приборов. Черновцы: Прут, 1992. 263 р.

Надійшла до редакції 19.05.2019

Прибыла А.В., канд. физ.-мат. наук<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Институт термоэлектричества НАН и МОН Украины, ул. Науки, 1, Черновцы, 58029, Украина, *e-mail: anatych@gmail.com;* <sup>2</sup>Черновицкий национальный университет имени. Юрия Федьковича, ул. Коцюбинского, 2, Черновцы, 58012, Украина

В работе приведены результаты проектирования термоэлектрического многокаскадного термоэлектрического модуля охлаждения рентгеновских детекторов. Разработана конструкция термоэлектрического охладителя в составе детектора рентгеновского излучения и проанализированы возможности его практического использования. Библ. 12, рис. 2. Ключевые слова: компьютерное проектирование, термоэлектрическое охлаждение, рентгеновский детектор.

## A.V. Prybyla<sup>1,2</sup> cand. phys. - math. sciences

<sup>1</sup>Institute of Thermoelectricity of the NAS and MES of Ukraine,
1, Nauky str., Chernivtsi, 58029, Ukraine; *e-mail: anatych@gmail.com*<sup>2</sup>Yu.Fedkovych Chernivtsi National University,
2, Kotsiubynskyi str., Chernivtsi, 58000, Ukraine

# DESIGN OF A THERMOELECTRIC COOLING MODULE FOR AN X-RAY DETECTOR

The paper presents the results of designing a thermoelectric multistage thermoelectric cooling module for X-ray detectors. The structure of a thermoelectric cooler as part of an X-ray detector is developed and the possibilities of its practical use are analyzed. Bibl. 12, Fig. 2. **Key words:** computer design, thermoelectric cooling, X-ray detector.

### References

- 1. Buhay O.M., Drozdenko M.O., Storizhko V.Yu. (2014). Microanalytical X-ray facility in IAP NASU. *Nanotechnology and Nanomaterials. Book of Abstracts.* Lviv.
- 2. Woldseth R. (1973). X-Ray energy spectrometry. Kevex: Scotts Valley, CA.
- 3. Stone R.E., Barkley V.A. and Fleming J.A. (1986). Performance of a Gamma-ray and X-ray spectrometer using Germanium and Si (Li) detectors cooled by a closed-cycle cryogenic mechanical refrigerator. *IEEE Trans. Nucl. Sci.* NS-33, 1, 299.
- 4. Broerman E.C., Keyser R.M., Twomey T.R., Upp D.L. *A new cooler for HPGe detector systems, ORTEC*. PerkinElmer Instruments: Inc Oak Ridge TN 37831-0895 USA.
- 5. Schlesinger TE, James RB. (1995). Semiconductors and semimetals. Vol. 43. Semiconductors for room temperature nuclear detector applications. New York: Academic Press.
- 6. Semiconductors for room-temperature detectors. Applications II. (1998). *Materials Research Society Symposium Proceedings*, Vol. 487. Materials Research Society: Warrendale, PA.
- 7. Sokolov, A., Loupilov, A., Gostilo, V. (2004). Semiconductor Peltier-cooled detectors for x-ray fluorescence analysis. *X-Ray Spectrometry*, *33*(6), *462–465. doi:10.1002/xrs.744*.
- 8. http://www.rmtltd.ru/applications/photodetectors/xray.php.
- 9. http://www.amptek.com/wp-content/uploads/2014/04/XR-100T-CdTe-X-ray-and-Gamma-Ray-Detector-Specifications.pdf.
- 10. Anatychuk L.I., Vikhor L.N. (2013). The limits of thermoelectric cooling for photodetectors. J. of *Thermoelectricity*, 5, 54-58.
- 11. COMSOL Multiphysics User's Guide (2010). COMSOLAB, 804 p.
- 12. Anatychuk L.I., Semeniuk V.A. (1992). *Optimalnoie upravleniie svoistvami termoelektricheskikh materialov i priborov [Optimal control over the properties of thermoelectric materials and instruments]*. Chernivtsi: Prut [in Russian].

Submitted 19.05.2019